InP (111) A- (1×1) の圧縮表面二重層に対する RHEED 波動場 RHEED Wave Field for Compressed Surface Bilayer of InP(111)A-(1×1) 大同大工¹,名大院工²,東北大多元研³ ⁰堀尾吉巳¹,柚原淳司²,高桑雄二³ Daido Univ.¹, Nagoya Univ.², IMRAM Tohoku Univ.³ [°]Yoshimi Horio¹, Junji Yuhara², Yuji Takakuwa³ E-mail: horio@daido-it.ac.jp

イオンスパッタと低温アニールで作成した InP(111)A-(1×1)表面の表面二重層内の間隔は、理想 的には d=0.85Åであるがロッキング曲線の解析から d=0.1Åと大きく圧縮されており、表面 In 原 子の欠陥割合は 30%程度有することを先回報告した。今回、この欠陥と圧縮緩和された表面二重 層を考慮した入射電子波動場を計算した。計算には00,±1±1,±2±2の5つのロッドを考慮し た。10kV 加速電子線を[112]方位に合わせ、例として視射角 $\theta=2.5^{\circ}$ と3.5°での波動場の計算結 果をそれぞれ Fig. 1(a),(b)に示す。これらは入射方位から見た波動場の断面図であり、黒い領域ほ ど電子密度は高い。最表面の圧縮された In と P 原子層は+記号で示し、上方が真空側である。Fig. 1(a),(b)の視射角は、1次ロッドの表面波共鳴(SWR)領域である $\theta=2.6^{\circ}$ (結晶内の閾値)から $\theta=3.4^{\circ}$ (真空側の閾値)の両閾値に近く、 $\theta=2.5^{\circ}$ では強い鏡面反射により真空側に強い定在波 が、 $\theta=3.5^{\circ}$ では11と11ビームの出現により表面平行方向に約2.1Å同期に変調された定在波が 確認される。+記号で示される原子位置から半径0.2Å以内の波動場強度の視射角変化をFig.2(b) に示す。これらの曲線は半値幅0.35°のガウス関数でコンボリュートしてある。表面二重層は圧

縮され、両原子層は接近しているためか In と P の 各原子列上の波動場強度の振舞いは似ており、SWR 領域の両閾値付近にピークを有することがわかる。 一方、Fig. 2(c)の In(MNN)と P(LMM)オージェ強度 の視射角依存性(BRAES プロファイル)も互いに よく似ており、SWR 領域で強度増大が見られ、Fig. 2(b)の計算波動場との相関性が認められる。参考ま でに Fig. 2(a)に示すように00ビームの実験ロッキ ング曲線(実線)は In 欠陥と圧縮二重層を用いた 計算ロッキング曲線(点線)でよく再現されている。





Fig. 2 (a) rocking curves of 00 spot, (b) calculated wave field intensity curves, and (c) experimental BRAES profiles.